

02:12

© 1991

## ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ПАМЯТЬ ЭФФЕКТА РОТШТЕЙНА В ЯДЕРНЫХ ЭМУЛЬСИЯХ

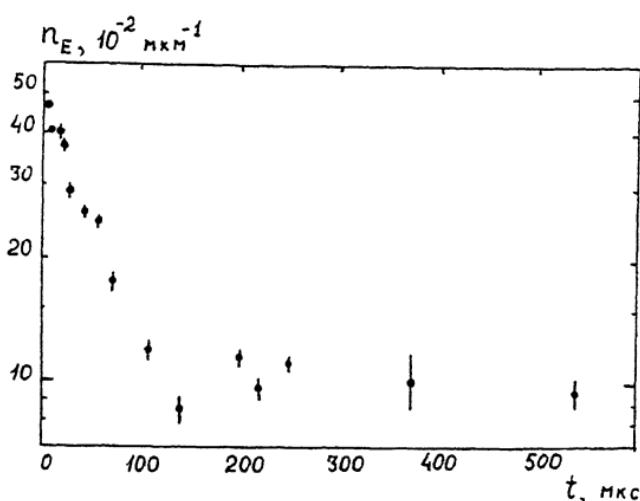
Е.М. Гущин, А.Н. Лебедев,  
 С.В. Сомов, М.К. Тимофеев,  
 Г.И. Типографчик

Существование „памяти” в эффекте увеличения чувствительности бромосеребряных эмульсий в импульсном электрическом поле (эффект Ротштейна) обычно объясняют промежуточным захватом свободных электронов на мелкие электронные уровни, не являющиеся центрами чувствительности [1]. По действием электрического поля напряженностью  $\sim 10^5\text{--}10^6$  В/см происходит срыв захваченных электронов (аналогично эффекту Шоттки) и их последующая мультиплексия посредством ударной ионизации. В такой модели время памяти должно быть связано с параметрами электронных ловушек, в частности, при наличии ловушек различной глубины, иметь многокомпонентный характер. До настоящего же времени наблюдалась только однокомпонентная память, что достаточно странно для эмульсионных микрокристаллов, содержащих как примесные, так и структурные центры захвата.

При исследовании управляемого режима регистрации быстрых заряженных частиц в примитивных ядерных эмульсиях (см., например, [2]) нами обнаружено одновременно две резко отличающиеся компоненты памяти – быстрая и медленная (см. рисунок), причем трековая чувствительность эмульсии, соответствующая этим компонентам, отличается почти в 5 раз. Можно показать, что в рамках ловушечной модели памяти полученные результаты описываются трехуровневой системой, состоящей из двух типов мелких ловушек различной глубины и глубокой ловушки (центра чувствительности). При этом срыв электронов электрическим полем возможен только с самого мелкого уровня, глубина которого, исходя из напряженности электрического поля в наших измерениях (2.1–2.5 МВ/см), не превышает 0.35 эВ.

Разделяя компоненты, мы получили значение времени памяти  $T_p \approx 40$  мкс для „быстрой” памяти и  $T_p \approx 3.5$  мс для „медленной”

Обнаружение двух компонент памяти эффекта Ротштейна является подтверждением правильности ловушечной модели. С практической точки зрения наличие двух резко различных по времени и по трековой чувствительности компонент памяти расширяет возможности управляемого эмульсионного трекового детектора, предназначенного для регистрации редких событий в присутствии интенсивного постороннего фона [3]. В зависимости от условий физического



Зависимость трековой чувствительности примитивной ядерной эмульсии РОК от задержки между моментом прохождения протона с энергией 200 МэВ и моментом приложения управляющего импульса электрического поля. Трековая чувствительность эмульсии в отсутствие электрического поля  $n_0 \leq 1 \cdot 10^{-2}$  мкм $^{-1}$ .

эксперимента такой детектор может теперь управляться либо „мягким” быстрым триггером, либо „жестким” медленным триггером. В первом случае задержка между полезным событием и управляющим электрическим импульсом мала, трековая чувствительность эмульсии велика, детектор допускает предельные загрузки  $\sim 10^8$  частиц/см $^2$ . Во втором случае предельные загрузки по крайней мере на порядок меньше, но зарегистрированная детектором информация обогащена полезными событиями.

#### С п и с о к л и т е р а т у р ы

- [1] Картужанский А.Л., Уланов В.М. // ФТП. 1981. Т. 15. № 5. С. 1000–1002.
- [2] Гущин Е.М., Лебедев А.Н., Лопырев А.Ю., Сомов С.В. // Письма в ЖТФ. 1985. Т. 11. № 8. С. 491–494.
- [3] Гущин Е.М., Лебедев А.Н., Лопырев А.Ю., Сомов С.В., Типографщик Г.И. // ПТЭ. 1988. № 1. С. 28–31.

Московский  
инженерно-физический  
институт

Поступило в Редакцию  
28 августа 1991 г.